



■ ■ 主要用途：通用运用程序、放大等。

Applications: General purpose application, switching.

■ ■ 特性

Features

特性参数 CHARACTERISTIC	符号 SYMBOL	额定值 RATING	单位 UNIT
集电极-基极电压 Collector-Base Voltage	V_{CB0}	40	V
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	25	V
发射极-基极电压 Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6	V
集电极电流 Collector Current	I_c	500	mA
集电极耗散功率 Collector Power Dissipation	P_c	625	mW
结温 Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度 Storage Temperature	T_{stg}	- 55~150	°C



■ ■ 引脚说明

Pin assignment

PIN NAME 管脚符号	PIN NUMBER 引脚序号	FUNCTION 功能
	SOT-23	
B	1	BASE
E	2	EMITTER
C	3	COLLECTOR

■ ■ 电参数

Electrical Characteristics($T_C = 25^{\circ}C$ unless otherwise noted)

特性参数 CHARACTERISTIC	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITIONS	最小值 MIN.	典型值 TYP.	最大值 MAX.	单位 UNIT
集电极-基极反向截止电流 Collector Cut-off Current	I_{cBO}	$V_{CB} = 35V, I_E = 0$			0.1	μA
集电极-基极反向击穿电压 Collector-Base Breakdown Voltage	BV_{CB0}	$I_c = 0.01mA, I_E = 0$	40			V
集电极-发射极反向击穿电压 Collector-Emitter Breakdown Voltage	BV_{CEO}	$I_c = 2mA, I_B = 0$	25			V
发射极-基极反向击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage	BV_{EBO}	$I_E = 0.1mA, I_c = 0$	6			V
直流电流增益 DC Current Gain	h_{FE}	$V_{CE} = 1V, I_c = 100mA$	100		500	
	h_{FE}	$V_{CE} = 1V, I_c = 500mA$	40			
集电极-发射极饱和压降 Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_c = 500mA, I_B = 50mA$			0.5	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_c = 500mA, I_B = 50mA$			1.2	V



Base-Emitter Saturation Voltage					
特征频率 Gain Bandwidth Product	f_T	$I_C=10\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$		100	MHz
输出电容 Collector Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0,$ $f=1\text{MHz}$		12	PF

■■ 打标、分档

DEVICE MARKING

打标 Marking	J3Y
分档 Value	200~300

■■ 尺寸图

DIMENSION

